



Instituto de Ciencias
Centro de Investigaciones en Dispositivos Semiconductores
Posgrado en Dispositivos Semiconductores

**“ÁNODO DE SILICIO PARA BATERÍA DE IÓN DE LITIO, CON CELDA
SOLAR TIPO SCHOTTKY INTERCONSTRUÍDA”**

*Tesis sometida como requisito para obtener el grado de
Maestro en Dispositivos Semiconductores*

Presentada por:

C. Oscar Vieyra Brito

Matricula: 221470100

Dirigida por:

Dra. Estela Gómez Barojas

Dr. Enrique Quiroga González

©BUAP, Marzo 31, 2023.

Todos los derechos reservados.

Beca CONACYT 109106



Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Nº 281096

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

Folio BUAP: 0179193

BUAP

ACTA DE EXAMEN DE GRADO

En la Ciudad de Puebla, Puebla siendo las 09:00 horas del día diez del mes de junio de 2024, reunido en

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA

Los integrantes del Honorable Jurado de Examen de Grado:

Presidente DRA. MARIA JOSEFINA ROBLES AGUILA

Secretario DR. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ JIMENEZ

Vocal DR. CESAR MARQUEZ BELTRAN

Proceden a examinar a: VIEYRA BRITO OSCAR

Quienes al terminar el examen resolvieron: APROBARLO POR UNANIMIDAD

para obtener: EL GRADO DE MAESTRO EN DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

Acto continuo el presidente del Jurado le hizo saber el resultado de su examen y le tomó la protesta de Ley correspondiente.

Se expide la presente Acta de Examen en la ciudad de Puebla, Puebla a 01 de julio del 2024.

Con las facultades conferidas por la Ley de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Estatuto Orgánico de la misma

CERTIFICAN

La presente Acta de Examen de Grado

EL SECRETARIO GENERAL DE LA BUAP

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

MTRO. JOSÉ MANUEL ALONSO OROZCO

MTRO. RICARDO VALDERRAMA VALDEZ

NOTAS IMPORTANTES AL REVERSO